DOCKET NO.: 277078US2PCT

IN THE UNITED STATES PATENT AND TRADEMARK OFFICE

IN RE APPLICATION OF: Kentarou TAMAKI, et al.

SERIAL NO.: NEW U.S. PCT APPLICATION

FILED: HEREWITH

INTERNATIONAL APPLICATION NO.: PCT/JP04/04242

INTERNATIONAL FILING DATE: March 26, 2004

FOR: OPTICAL WAVEGUIDE CHIP AND OPTICAL COMPONENT COMPRISING SAME

REQUEST FOR PRIORITY UNDER 35 U.S.C. 119 AND THE INTERNATIONAL CONVENTION

Commissioner for Patents Alexandria, Virginia 22313

Sir:

In the matter of the above-identified application for patent, notice is hereby given that the applicant claims as priority:

COUNTRY

<u>APPLICATION NO</u>

DAY/MONTH/YEAR

Japan 2003-096435

31 March 2003

Certified copies of the corresponding Convention application(s) were submitted to the International Bureau in PCT Application No. PCT/JP04/04242. Receipt of the certified copy(s) by the International Bureau in a timely manner under PCT Rule 17.1(a) has been acknowledged as evidenced by the attached PCT/IB/304.

Respectfully submitted, OBLON, SPIVAK, McCLELLAND, MAIER & NEUSTADT, P.C.

Marvin J. Spivak Attorney of Record

Registration No. 24,913

Surinder Sachar

Registration No. 34,423

Customer Number 22850

(703) 413-3000 Fax No. (703) 413-2220 (OSMMN 08/03)

\Box JAPAN PATENT OFFICE

26. 3. 2004

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日 Date of Application:

2003年 3月31日

出 願 Application Number:

特願2003-096435

[ST. 10/C]:

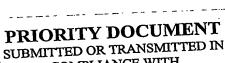
[JP2003-096435]

出 人 Applicant(s):

光伸光学工業株式会社

JSR株式会社

REC'D 2 1 MAY 2004 PCT WIPO



COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

特許庁長官 Commissioner, Japan Patent Office 2004年 4月30日



【書類名】

特許願

【整理番号】

10056

【あて先】

特許庁長官 殿

【国際特許分類】

G02B 6/12

【発明者】

【住所又は居所】

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイエスアー

ル株式会社内

【氏名】

玉木 研太郎

【発明者】

【住所又は居所】

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイエスアー

ル株式会社内

【氏名】

高瀬 英明

【発明者】

【住所又は居所】

東京都中央区築地二丁目11番24号 ジェイエスアー

ル株式会社内

【氏名】

江利山 祐一

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県秦野市菩提69番地3 光伸光学工業株式会社

内

【氏名】

大羽 伸治

【発明者】

【住所又は居所】

神奈川県秦野市菩提69番地3 光伸光学工業株式会社

内

【氏名】

藤原 英之

【特許出願人】

【識別番号】

394023182

【氏名又は名称】

光伸光学工業株式会社

【特許出願人】

【識別番号】 000004178

【氏名又は名称】 ジェイエスアール株式会社

【代理人】

【識別番号】

100103539

【弁理士】

【氏名又は名称】 衡田 直行

【手数料の表示】

【予納台帳番号】 064655

【納付金額】

21,000円

【提出物件の目録】

【物件名】

明細書 1

【物件名】

図面 1

【物件名】

要約書 1

【プルーフの要否】 要

【書類名】

明細書

【発明の名称】

光導波路チップ及びそれを含む光学部品

【特許請求の範囲】

【請求項1】 光導波路であるコア部と、該コア部の周囲に形成されたクラッド部と、前記コア部に接続される光ファイバを位置決めするための光ファイバ用ガイド部とを有する光導波路チップであって、少なくとも部分的に感放射線性ポリシロキサン組成物の硬化体からなることを特徴とする光導波路チップ。

【請求項2】 前記コア部、前記クラッド部、及び光ファイバ用ガイド部が、感放射線性ポリシロキサン組成物の硬化体からなる請求項1に記載の光導波路チップ。

【請求項3】 前記光導波路チップは、シングルモード用光ファイバに接続するためのものである請求項1又は2に記載の光導波路チップ。

【請求項4】 前記光導波路チップは、前記コア部に交差して配設される光学フィルタを挿入するための光学フィルタ挿入用孔を有する請求項1~3のいずれか1項に記載の光導波路チップ。

【請求項5】 請求項4に記載の光導波路チップの前記光学フィルタ挿入用 孔に、誘電体多層フィルタを挿入し固定してなることを特徴とする光学部品。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】

本発明は、光通信に用いられる光合分波器の如き光学部品の構成部分として有用な光導波路チップに関し、特に、シングルモード用光ファイバと接続して好適に用いられる光導波路チップに関する。

[0002]

【従来の技術】

光導波路を有する光合分波器と、光ファイバとを接続するに際し、光導波路の 光軸と光ファイバの光軸を高い精度で合わせることは、接続箇所における光伝送 損失を低減させるために必要不可欠である。

そのため、従来より、光導波路の光軸と光ファイバの光軸を合わせるための技

術が提案されている。

例えば、支持体上の感光性樹脂にフォトリソグラフ法を施すことによって、光軸合わせ用ガイド及び光導波路を同時に形成させた光デバイスが、提案されている(特許文献1及び特許文献2参照)。

ここで、光軸合わせ用ガイドとは、光導波路の端面と接続される光ファイバの 光軸と、光導波路の光軸を精度良く合わせるために設けられるものである。光軸 合わせ用ガイドの形状は、光ファイバの形状に依存して定められる。

また、光軸合わせ用ガイド等の材料である感光性樹脂としては、例えば、波長 0.66μmの光を伝送することのできるメタクリレート系樹脂が用いられる。

[0003]

【特許文献1】

特開平1-316710号公報(第1頁の特許請求の範囲、第3頁左 上欄第3~10行、同頁右上欄第5~11行、第4頁左上欄~右上欄の実施例1)

【特許文献2】

特開平2-62502号公報(第1頁の特許請求の範囲、第3頁左下欄~第4頁左上欄の実施例1)

[0004]

【発明が解決しようとする課題】

上述の特許文献1、2に記載されている波長0.66μmの光は、マルチモード用光ファイバによって伝送されるものである。

一方、光ファイバの種類としては、マルチモード用光ファイバの他に、一般の幹線系で用いられる波長 1. 31μ mや 1. 55μ mのシングルモード光を伝送するためのシングルモード用光ファイバが存在する。

このシングルモード用光ファイバは、コア部の直径が約10μmと小径であり、マルチモード用光ファイバのコア部と比較して直径で約1/5、断面積で約1/25と小さいため、光軸同士を高い精度で合わせることのできるシングルモード用光デバイスを必要とする。

[0005]

上述の特許文献1、2の技術をシングルモード用光デバイスに適用すると、次のような問題点がある。

- (1) (メタ) アクリレート系感放射線性樹脂を材料として用い、フォトリソグラフ法でシングルモード用光学部品を作製した場合には、シングルモード用光学部品の光導波路の光軸と、小径のシングルモード用光ファイバの光軸を高い精度で合わせることが困難である。
- (2) (メタ) アクリレート系感放射線性樹脂を用いたのでは、 1.31μ mや 1.55μ mの波長における光吸収量が大きいため、実用的な伝送効率を得ることができない。
 - (3) 光デバイスの信頼性を高めるために要求される耐熱性が、十分でない

[0006]

特に、上記(1)の問題点を解決するためには、フォトリソグラフ法による解像度を高めるために、有機溶剤による現像方法に代えて、アルカリ性水溶液等の塩基性物質含有溶液によるアルカリ現像法を用いることが必要である。ところが、(メタ)アクリレート系感放射線性樹脂とアルカリ性水溶液とを併用すると、アルカリ現像のために樹脂中に必要とされる酸成分が、シングルモード光の使用波長(1.31 μ m、1.55 μ m)において光吸収を示すことから、光の伝送効率が低下するという問題が生じてしまう。

そこで、本発明は、上記従来の技術の問題点に鑑みて、シングルモード用光ファイバに対しても光軸同士を高い精度で合わせることができ、シングルモード光の伝送効率が高く、しかも、優れた耐熱性を有する光導波路チップを提供することを目的とする。

[0007]

【課題を解決するための手段】

本発明者は、上記課題を解決するために鋭意検討した結果、従来の(メタ)ア クリレート系樹脂に代えて、ポリシロキサン系感放射線性樹脂を用い、かつ、光 ファイバを高精度で位置決めするための手段を設けることによって、上記目的に 合致する光導波路チップ (特に、シングルモード用光ファイバとの接続用として 好適に用い得る光導波路チップ)が得られることを見出し、本発明を完成した。 すなわち、本発明(請求項1)の光導波路チップは、光導波路であるコア部と、該コア部の周囲に形成されたクラッド部と、前記コア部に接続される光ファイバを位置決めするための光ファイバ用ガイド部とを有する光導波路チップであって、少なくとも部分的に感放射線性ポリシロキサン組成物の硬化体からなることを特徴とする。

このように構成された本発明の光導波路チップは、シングルモード用光ファイバに対しても光軸同士を高い精度で合わせることができ、シングルモード光の伝送効率が高く、しかも、優れた耐熱性を有している。

[0008]

本発明の光導波路チップは、好ましくは、前記コア部、前記クラッド部、及び 光ファイバ用ガイド部が、感放射線性ポリシロキサン組成物の硬化体からなるも のとして構成される(請求項2)。

このように構成された光導波路チップは、より一層優れた光軸合わせの精度、 光の伝送効率、及び耐熱性を有するとともに、簡易な工程によって効率的に製造 することができる。

なお、光ファイバ用ガイド部は、クラッド部と一体的に形成させてもよいし、 あるいは、クラッド部と独立して形成させてもよい。

本発明の光導波路チップは、特に、シングルモード用光ファイバに接続するための光導波路チップとして好適に用いられる(請求項3)。

本発明の光導波路チップは、前記コア部に交差して配設される光学フィルタを 挿入するための光学フィルタ挿入用孔を有することができる(請求項4)。

前記光学フィルタ挿入用孔に誘電体多層フィルタを挿入し固定することによって、前記光導波路チップに誘電体多層フィルタを取り付けてなる光学部品(例えば、光合分波器)を作製することができる(請求項5)。

[0009]

【発明の実施の形態】

以下、本発明について詳しく説明する。

まず、本発明の光導波路チップの材料として用いられる感放射線性ポリシロキ

サン組成物について説明する。

本発明で用いる感放射線性ポリシロキサン組成物は、好ましくは、下記の(A)成分及び(B)成分:

- (A)加水分解性シラン化合物、その加水分解物、及び加水分解物の縮合物からなる群より選択される少なくとも1種
 - (B) 光酸発生剤

を含有するものである。

以下、これら(A)成分及び(B)成分の各々について説明する。

[0010]

「(A)成分]

(A) 成分は、加水分解性シラン化合物、その加水分解物、及び加水分解物の 縮合物からなる群より選択される少なくとも1種である。

ここで、加水分解性シラン化合物は、次の一般式(1)で表される化合物である。

$$(R^{1})_{p} S i (X)_{4-p}$$
 (1)

(式中、R 1 は炭素数が $1\sim1$ 2 である非加水分解性の有機基であり、X は加水分解性基であり、p は $0\sim3$ の整数である。)

一般式(1)中の有機基R¹は、非加水分解性である1価の有機基の中から選択することができる。ここで、非加水分解性である1価の有機基は、非重合性と重合性のいずれであってもよい。また、「非加水分解性」の語は、加水分解性基Xが加水分解される条件において、そのまま安定に存在する性質を有することを意味する。

[0011]

非重合性の有機基R¹としては、例えば、アルキル基、アリール基、アラルキル基等が挙げられる。これらの有機基は、直鎖状、分岐状、環状のいずれであってもよく、あるいは、これらの組み合わせであってもよい

ここで、アルキル基としては、例えば、メチル基、エチル基、プロピル基、プ チル基、ヘキシル基、シクロヘキシル基、オクチル基、重水素化アルキル基、ハ ロゲン化アルキル基等が挙げられる。中でも、メチル基は、好ましく用いられる アリール基としては、例えば、フェニル基、トリル基、キシリル基、ナフチル 基、ビフェニル基、重水素化アリール基、ハロゲン化アリール基等が挙げられる 。中でも、フェニル基は、好ましく用いられる。

アラルキル基としては、例えば、ベンジル基、フェニルエチル基等が挙げられる。中でも、ベンジル基は、好ましく用いられる。

[0012]

非重合性の有機基R¹の好ましい例として、ヘテロ原子を含む構造単位が挙げられる。該構造単位としては、例えば、エーテル結合、エステル結合、スルフィド結合等が挙げられる。なお、ヘテロ原子を含む場合、非塩基性であることが好ましい。

[0013]

重合性の有機基R¹は、分子中にラジカル重合性の官能基とカチオン重合性の 官能基のいずれか一方または両方を有することが好ましい。該官能基を有する場 合、光重合に加えてラジカル重合やカチオン重合が行なわれるので、より効果的 に感放射線性ポリシロキサン組成物を硬化させることができる。

ラジカル重合性の官能基と、カチオン重合性の官能基のうち、より好ましい官能基は、カチオン重合性の官能基である。(A)成分中にカチオン重合性の官能基が含まれていると、(B)成分の光酸発生剤によって、シラノール基における硬化反応のみならず、カチオン重合性の官能基における硬化反応も同時に生じるので、硬化が促進され、製造効率が高まるからである。

[0014]

一般式(1)中の加水分解性基Xとしては、例えば、水素原子、炭素数1~1 2のアルコキシ基、フェノキシ基、ベンジロキシ基、アセトキシ基、グリシジロキシ基、フェノキシベンジロキシ基、ハロゲン原子、アミノ基等が挙げられる。

ここで、炭素数1~12のアルコキシ基の好ましい具体例としては、例えば、 メトキシ基、エトキシ基、プロポキシ基、ブトキシ基、メトキシエトキシ基、ア セトキシエトキシ基、2 - (メタ) アクリロキシエトキシ基、3 - (メタ) アク リロキシプロポキシ基、4 - (メタ) アクリロキシプトキシ基等の他、2 - (3



. 4-エポキシシクロヘキシル)エトキシ基等のエポキシ基含有アルコキシ基; メチルオキセタニルメトキシ基、エチルオキセタニルメトキシ基等のオキセタニ ル基含有アルコキシ基;オキサシクロヘキシロキシ等の6員環エーテル基を有す るアルコキシ基等が挙げられる。

[0015]

ハロゲン原子の好ましい具体例としては、例えば、フッ素、塩素、臭素、ヨウ 素等が挙げられる。

なお、(A)成分として、加水分解性基がハロゲン原子である加水分解性シラ ン化合物を用いる場合には、加水分解によってハロゲン化水素が生成し、感放射 線性ポリシロキサン組成物の保存安定性を低下させることがあるので、ハロゲン 化水素の生成量の多少によっても必要性の有無が異なるが、中和や蒸留等の操作 によってハロゲン化水素を除去することが望ましい。

[0016]

次に、本発明で用いる加水分解性シラン化合物の具体例を説明する。

まず、一般式(1)中のpが0であって、非加水分解性の有機基R¹を有しな い加水分解性シラン化合物としては、テトラクロロシラン、テトラアミノシラン 、テトラアセトキシシラン、テトラメトキシシラン、テトラエトキシシラン、テ トラブトキシシラン、テトラフェノキシシラン、テトラベンジロキシシラン、ト リメトキシシラン、トリエトキシシラン等の4個の加水分解性基で置換されたシ ラン化合物が挙げられる。

[0017]

また、一般式(1)中の p が 1 である加水分解性シラン化合物としては、メチ ルトリクロロシラン、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシラン、 メチルトリブトキシシラン、エチルトリメトキシシラン、エチルトリイソプロポ キシシラン、エチルトリブトキシシラン、ブチルトリメトキシシラン、ペンタフ ルオロフェニルトリメトキシシラン、フェニルトリメトキシシラン、フェニルト リエトキシシラン、重水素化メチルトリメトキシシラン、ノナフルオロブチルエ チルトリメトキシシラン、トリフルオロメチルトリメトキシシラン等が挙げられ る。

[0018]

また、一般式(1)中のpが2である加水分解性シラン化合物としては、ジメチルジクロロシラン、ジメチルジアミノシラン、ジメチルジアセトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、ジフェニルジエトキシシラン、ジブチルジメトキシシラン等が挙げられる。

さらに、一般式(1)中のpが3である加水分解性シラン化合物としては、トリメチルクロロシラン、ヘキサメチルジシラザン、トリメチルシラン、トリブチルシラン、トリメチルメトキシシラン、トリブチルエトキシシラン等が挙げられる。

[0019]

本明細書中において、加水分解性シラン化合物の「加水分解物」とは、一般式 (1)で表される加水分解性シラン化合物において、加水分解性基Xの全部が加水分解されたものだけでなく、加水分解性基Xの一部のみが加水分解され、残部 が加水分解されていないものを含む意で用いられる。

また、本明細書中において、加水分解性シラン化合物の「加水分解物の縮合物」とは、加水分解によってアルコキシ基から変化したシラノール基の全部が縮合したものだけでなく、一部のシラノール基同士が縮合した部分縮合物を含む意で用いられる。

[0020]

本発明においては、加水分解性シラン化合物の種類を適宜選択することによって、光導波路における屈折率の値を幅広く変化させることができる。例えば、比較的高い屈折率の値(1.50以上)を得たい場合には、上述の加水分解性シラン化合物のうち、フェニルトリメトキシシラン、フェニルトリエトキシシラン、ジフェニルジメトキシシラン、ジフェニルジエトキシシラン等を使用することが好ましい。

[0021]

一方、比較的低い屈折率の値(1.50未満)を得たい場合には、上述の加水 分解性シラン化合物のうち、メチルトリメトキシシラン、メチルトリエトキシシ ラン、ノナフルオロブチルエチルトリメトキシシラン、ジメチルジクロロシラン 、ジメチルジアミノシラン、ジメチルジアセトキシシラン、ジメチルジメトキシシラン、3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8ーへプタデカフルオロデシルトリクロロシラン、3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8ーへプタデカフルオロデシルトリメトキシシラン等を使用することが好ましい。

[0022]

- (A) 成分は、通常、一般式 (1) で表される加水分解性シラン化合物を加熱することによって調製される。具体的な調製方法は、特に限定されないが、例えば、次の (1) ~ (1) の工程からなる方法が挙げられる。
- 1) 一般式(1)で表される加水分解性シラン化合物、及び酸触媒を、攪拌手段を有する容器内に収容する。
- 2) 次いで、容器内の溶液の粘度を調節しながら、有機溶媒を加えて、混合溶液とする。
- 3)得られた混合溶液を、空気雰囲気中で、有機溶媒及び加水分解性シラン化合物の沸点以下の温度下で撹拌しながら、水を滴下した後、150℃以下で1~24時間加熱しつつ撹拌する。なお、撹拌時に、必要に応じて、蒸留によって混合溶液を濃縮したり、あるいは有機溶媒を置換してもよい。

[0023]

(A) 成分を調製するに際し、感放射線性ポリシロキサン組成物の硬化性、粘度等の物性や、該組成物の硬化物の屈折率等を調整するために、上述の一般式(1)で表される加水分解性シラン化合物を1種だけでなく複数種を併用することもできる。この場合、上記1)の工程において、一般式(1)で表される複数種の加水分解性シラン化合物を容器内に収容して混合すればよい。

[0024]

上述の1)の工程で用いる酸触媒としては、例えば、1価または多価の有機酸、無機酸、ルイス酸等が挙げられる。

ここで、有機酸としては、例えば、蟻酸、酢酸、シュウ酸等が挙げられる。無機酸としては、例えば、塩酸、硝酸、硫酸等が挙げられる。ルイス酸としては、例えば、金属化合物や、Ti、Zr、Al、B等の無機塩や、アルコキシドや、

ページ: 10/

カルボキシレート等が挙げられる。

[0025]

上述の2)、3)の工程で用いる有機溶媒としては、例えば、エーテル系有機溶媒、エステル系有機溶媒、ケトン系有機溶媒、炭化水素系有機溶媒、アルコール系有機溶媒等が挙げられる。

中でも、大気圧下での沸点が50~200℃であり、かつ各成分を均一に溶解させることのできる有機溶媒は、好ましく用いられる。このような有機溶媒の具体例としては、例えば、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノメチルエーテル、アロピレングリコールモノメチルエーテルアセテート、乳酸エチル、メチルイソブチルケトン、メチルアミルケトン、トルエン、キシレン、メタノール等が挙げられる。

[0026]

次に、(A)成分として用いられる加水分解性シラン化合物の加水分解物、及びその縮合物の重量平均分子量について説明する。

該重量平均分子量は、本明細書中において、移動相にテトラヒドロフランを使用したゲルパーミエーションクロマトグラフィー(以下、「GPC」と略記する。)を用いて得られるポリスチレン換算の値として表される。

該重量平均分子量は、好ましくは $500\sim10$, 000、より好ましくは1, $000\sim5$, 000である。該重量平均分子量が500未満では、塗膜の成膜性が低下することがあり、該重量平均分子量が10, 000を超えると、光硬化性が低下することがある。

[0027]

[(B)成分]

感放射線性ポリシロキサン組成物に含まれる(B)成分である光酸発生剤は、 光等のエネルギー線を照射することによって、(A)成分である加水分解性シラン化合物等を光硬化(架橋)させるための酸性活性物質を放出することができる 化合物と定義される。

ここで、エネルギー線としては、例えば、可視光、紫外線、赤外線、X線、 α 線、 β 線、 γ 線等が挙げられる。中でも、紫外線は、一定のエネルギーレベルを有し、硬化速度が大であり、しかも照射装置が比較的安価かつ小型であることか

ら、好ましく用いられる。

[0028]

(B) 成分である光酸発生剤の種類としては、例えば、下記の一般式(2)で表されるオニウム塩や、下記の一般式(3)で表されるスルフォン酸誘導体を挙げることができる。

$$[R^{2} a R^{3} b R^{4} c R^{5} dW] + m [MZ_{m+n}] - m$$
 (2)

(式中、カチオンはオニウムイオンであり、WはS、Se、Te、P、As、Sb、Bi、O、I、Br、Clまたは $-N \equiv N$ であり、R²、R³、R⁴及びR5は同一または異なる有機基であり、a、b、c及びdは各々0~3の整数であって、(a+b+c+d)はWの価数に等しい。また、Mは錯体 [MZ $_m+n$]の中心原子を構成する金属またはメタロイドであり、例えばB、P、As、Sb、Fe、Sn、Bi、Al、Ca、In、Ti、Zn、Sc、V、Cr、Mn、Coである。Zは、F、Cl、Br等のハロゲン原子またはアリール基であり、mは錯体イオンの正味の電荷であり、nはMの原子価である。)

[0029]

$$Q_s - [S (=0)_2 - R^6]_t$$
 (3)

(式中、Qは1価または2価の有機基であり、R 6 は炭素数 $1\sim12$ の1価の有機基であり、 $_8$ は0または1であり、 $_1$ は1または2である。)

(B) 成分である光酸発生剤の添加量は、特に限定されないが、(A) 成分100重量部に対して、好ましくは0.1~15重量部であり、より好ましくは1~10重量部である。該添加量が0.1重量部未満では、光硬化性が低下して、十分な硬化速度が得られない傾向がある。該添加量が15重量部を超えると、得られる硬化物の耐候性や耐熱性が低下する傾向がある。

[0030]

本発明においては、(A)成分及び(B)成分を含む感放射線性ポリシロキサン組成物を支持体上に塗布し、フォトリソグラフ法によって光硬化させることによって、光導波路チップが製造される。

ここで、フォトリソグラフ法とは、所定の形状パターンを有するフォトマスク を介する等によって、紫外線等のエネルギー線を支持体上の感放射線性組成物に 照射した後、現像液に対する照射部分と非照射部分の溶解度の差を利用して、例 えば非照射部分を除去し、硬化体として残る照射部分のみからなる所定の形状パ ターンを有する成形体(例えば、光導波路)を得る方法をいう。

[0031]

感放射線性ポリシロキサン組成物は、加工性、伝送特性、耐熱性に優れているので、シングルモード用光ファイバに接続するための光導波路チップの材料として用いることによって、光導波路チップ中のコア部(光導波路)の光軸とシングルモード用光ファイバの光軸とを高精度で合わせることができるとともに、シングルモード光の伝送効率を高くすることができ、さらには、高温下に置かれても優れた性能を保持することができる。

[0032]

次に、本発明の光導波路チップの構造及び製造方法を、図面に基づいて説明する。図1は、光導波路チップの一例を示す斜視図、図2は、基板上に下部クラッド層を形成させた状態を示す斜視図、図3は、下部クラッド層の上にコア部を形成させた状態を示す斜視図、図4は、光導波路チップの他の例を示す斜視図、図5は、下部クラッド層の一例を示す平面図、図6は、下部クラッド層の上にコア部を形成させた状態を示す平面図、図7は、下部クラッド層及びコア部の上に上部クラッド層を形成させて光導波路チップを完成させた状態を示す平面図、図8は、図7に示す光導波路チップに光学フィルタ及び光ファイバを取り付けた状態を示す平面図である。

[0033]

図1中、本発明の光導波路チップ1は、光導波路であるコア部6と、コア部6の周囲に形成された上部クラッド層5及び下部クラッド層4からなるクラッド部3と、クラッド部3と一体的に形成された光ファイバ用ガイド部7とを有している。

コア部6は、光ファイバ用ガイド部7に挿入される光ファイバ(図示せず)と 光軸同士が一致するような位置に設けられる。

クラッド部3は、コア部6を支持し保護するためのものであり、製造上の理由 によって、基板(支持体)2上に形成される下部クラッド層4と、下部クラッド 層4の上に積層される上部クラッド層5との2層構造を有するものとして構成されている。なお、クラッド部3は、コア部6の全周を被覆するように形成することが望ましいが、コア部6の周囲の一部のみ(例えば、上部を除く側部及び下部のみ)に形成させてもよい。

[0034]

光ファイバ用ガイド部7は、コア部6に接続される光ファイバを位置決めする ための案内手段である。光ファイバ用ガイド部7は、クラッド部3と一体的に形 成された感放射線性ポリシロキサン組成物からなる硬化体であり、光ファイバを 位置決めして固定することのできる形状に形成されている。

光ファイバ用ガイド部7を基板に対して垂直方向に切断した断面形状は、特に限定されないが、例えば、U字底型、V字底型、平底型等が挙げられる。

光ファイバ用ガイド部7は、光ファイバの外径寸法に略一致する距離を隔てて設けられた対向する一対の壁体を、少なくとも1つ以上有することが好ましい。 このような壁体を設けることによって、光ファイバ用ガイド部7に挿入した後の 光ファイバの緩みや軸ぶれを、より確実に防止することができる。

[0035]

光導波路チップ1は、クラッド部3の上面から下方に垂下してコア部6を遮断するように設けられた光学フィルタ挿入用孔8を有している。光学フィルタ挿入用孔8は、誘電体多層フィルタの如き光学フィルタを挿入して固定するための孔である。

光導波路チップ1の各構成部分の寸法は、例えば、下部クラッド層4の厚みが $3\sim100\,\mu\,\mathrm{m}$ 、コア部6の厚みが $3\sim20\,\mu\,\mathrm{m}$ 、コア部6の幅が $1\sim50\,\mu\,\mathrm{m}$ 、上部クラッド層5の厚みが $3\sim100\,\mu\,\mathrm{m}$ 、光ファイバ用ガイド部7を構成する一対の壁体間の距離(切欠部分の幅寸法)が $125\,\mu\,\mathrm{m}\sim130\,\mu\,\mathrm{m}$ 、光学フィルタ挿入用孔8の深さが $10\sim200\,\mu\,\mathrm{m}$ となるように定めることが好ましい

なお、光ファイバ用ガイド部7を構成する一対の壁体間の距離(切欠部分の幅 寸法)は、光ファイバの外径に応じて定められる。

[0036]

図1中の光導波路チップ1を構成する各構成部分(コア部6、クラッド部3及 び光ファイバ用ガイド部7)は、感放射線性ポリシロキサン組成物の硬化体から 形成されている。

ただし、本発明においては、必ずしも、光導波路チップ1の構成部分(コア部6、クラッド部3及び光ファイバ用ガイド部7)の全体を感放射線性ポリシロキサン組成物の硬化体から形成する必要はなく、これら構成部分の一部のみを感放射線性ポリシロキサン組成物の硬化体から形成することもできる。例えば、コア部6を、感放射線性ポリシロキサン組成物の硬化体から形成し、クラッド部3及び光ファイバ用ガイド部7を、他の材料(例えば、石英ガラス等)から形成することができる。

[0037]

光導波路チップ1においては、コア部6の屈折率の値を、クラッド部3(下部クラッド層4及び上部クラッド層5)の屈折率の値よりも大きくすることが必要である。

具体的には、コア部6の屈折率の値は、クラッド部3の屈折率の値よりも0.002~0.5ほど大きい値であることが好ましい。

特に優れた導波特性を得るためには、例えば、波長 $1300\sim1600$ nmの光に対して、コア部6の屈折率を $1.450\sim1.650$ に調整し、かつ、下部クラッド層4及び上部クラッド層5の屈折率を $1.400\sim1.648$ に調整することが好ましい。

なお、本発明においては、光導波路チップ1の材料として、感放射線性ポリシロキサン組成物と共に、感放射線性ポリイミド組成物等を併用することもできる

[0038]

本発明においては、図4に示すように、光ファイバ用ガイド部17は、クラッド部13と独立させて形成させてもよい。この場合、光ファイバ用ガイド部17は、下部クラッド層14及び上部クラッド層15の各々の形成と同時に、順次積層して形成させてもよいし、あるいは、下部クラッド層14と上部クラッド層15のいずれかの形成と同時に一度に形成させてもよい。

なお、図4中、光導波路チップ10は、基板12上に形成された下部クラッド層14及び光ファイバ用ガイド部17と、下部クラッド層14上に積層して形成されたコア部16及び上部クラッド層15とから構成されている。また、光導波路チップ10には、上部クラッド層15の上面から下部クラッド層14の下面に亘って貫通する光学フィルタ挿入用孔18が、コア部16の光軸方向と略垂直に交差してコア部16を遮断するように、形成されている。

[0039]

次に、本発明の光導波路チップの製造方法の一例を、図5~図8に基づいて説明する。

本発明の光導波路チップの製造方法は、(a)下部クラッド層形成工程と、(b)コア部形成工程と、(c)上部クラッド層形成工程とを含むものである。これらの工程(a)~(c)によって、光ファイバ用ガイド部及び光学フィルタ挿入用孔も、下部クラッド層等の形成と同時に形成される。

[0040]

「(a)下部クラッド層形成工程]

シリコン基板やガラス基板の如き平坦な面を有する基板(支持体)の上面に、 下部クラッド層21を形成させる工程である(図5参照)。

この工程では、まず、基板(図示せず)の上面に、下部クラッド層用の感放射線性ポリシロキサン組成物を塗布した後、乾燥またはプリベーク(前処理としての加熱処理)して、下部クラッド層用の薄膜を形成させる。

ここで、下部クラッド層用の感放射線性ポリシロキサン組成物を塗布する方法 としては、例えば、スピンコート法、ディッピング法、スプレー法、バーコート 法、ロールコート法、カーテンコート法、グラビア印刷法、シルクスクリーン法 、インクジェット法等を用いることができる。中でも、スピンコート法は、均一 な厚みを有する薄膜が得られることから、好ましく用いられる。

[0041]

下部クラッド層用の薄膜に、所定の形状を有するフォトマスクを介して、光照 射することによって、薄膜を構成する材料を部分的に硬化させることができる。 ここで、照射に用いられる光は、特に限定されないが、通常、200~450 nmの紫外~可視領域の光、好ましくは、波長 365 nmの紫外線を含む光が用いられる。光は、波長 200~450 nmでの照度が 1~1000 mW/c m²、照射量が 0.01~5000 mJ/c m²、好ましくは 0.1~1000 mJ/c m²となるように、所定のパターンで被照射体(感放射線性ポリシロキサン組成物)に照射される。

[0042]

所定のパターンで光を照射する方法としては、光の透過部及び非透過部を有するフォトマスクを用いる方法以外に、例えば、以下に示す a~cの方法が挙げられる。

- a. 液晶表示装置と同様の原理を利用した、所定のパターンに従って光透過領域と不透過領域とからなるマスク像を電気光学的に形成する手段を利用する方法。
- b. 多数の光ファイバーを束ねてなる導光部材を用い、この導光部材における 所定のパターンに対応する光ファイバーを介して光を照射する方法。
- c. レーザ光、あるいはレンズ、ミラー等の集光性光学系により得られる収束 光を走査させながら、光硬化性組成物に照射する方法。

[0043]

下部クラッド層用の薄膜は、必要に応じて、光の照射後、50~200℃でプリベークしてもよい。

光の照射後、現像液によって非照射部分(未露光部分)を現像することによって、未硬化の不要な部分が除去され、基板上に、パターニングされた硬化膜からなる下部クラッド層 2 1 (すなわち、光ファイバ用ガイド部 2 2, 2 3, 2 4 及び光学フィルタ挿入用孔 2 5 を有する所定の厚みの硬化体層)を形成させることができる。

[0044]

現像に用いる現像液としては、塩基性物質を溶媒で希釈してなる溶液を用いる ことができる。

ここで、塩基性物質としては、例えば、水酸化ナトリウム、水酸化カリウム、 炭酸ナトリウム、ケイ酸ナトリウム、メタケイ酸ナトリウム、アンモニア、エチ ルアミン、n-プロピルアミン、ジエチルアミン、ジーn-プロピルアミン、トリエチルアミン、メチルジエチルアミン、エタノールアミン、N-メチルエタノールアミン、N, N-ジメチルエタノールアミン、トリエタノールアミン、テトラメチルアンモニウムヒドロキシド、テトラエチルアンモニウムヒドロキシド、フリン、ピロール、ピペリジン、1, 8-ジアザビシクロ[5.4.0]-7-ウンデセン、1, 5-ジアザビシクロ[4.3.0]-5-ノナン等が挙げられる。

溶媒としては、例えば、水、メタノール、エタノール、プロピルアルコール、 ブタノール、オクタノール、プロピレングリコールモノメチルエーテル、プロピレングリコールモノエチルエーテル、Nーメチルピロリドン、ホルムアミド、N Nージメチルホルムアミド、N Nージメチルアセトアミド等が挙げられる。

[0045]

現像液中の塩基性物質の濃度は、通常、 $0.05\sim25$ 重量%、好ましくは $0.1\sim3.0$ 重量%である。

現像時間は、通常、30~600秒間である。現像方法としては、例えば、液盛り法、ディッピング法、シャワー現像法等を採用することができる

現像液の溶媒として有機溶媒を用いた場合には、そのまま風乾すれば、有機溶媒が蒸散して、パターン状の薄膜が形成される。

現像液の溶媒として水(または水溶液)を用いた場合には、例えば、流水による洗浄を30~90秒間行なった後、圧縮空気や圧縮窒素等を用いて風乾して水分を除去すれば、パターン状の薄膜が形成される。

[0046]

なお、露光後には、露光部分の硬化を促進させるために、加熱処理を行なうことが好ましい。その加熱条件は、感放射線性ポリシロキサン組成物の成分組成や添加剤の種類等によっても異なるが、通常、30~200℃、好ましくは50~150℃である。

露光後の加熱処理に加えて、さらに、薄膜の全面が十分に硬化するように、ポストベーク(後処理の加熱処理)を行なうことが好ましい。その加熱条件は、感放射線性ポリシロキサン組成物の成分組成や添加剤の種類等によっても異なるが

、通常、30~400℃、好ましくは50~300℃である。加熱時間は、特に 限定されないが、例えば、5分間~72時間である。

下部クラッド層形成工程(a)における感放射線性ポリシロキサン組成物の塗布方法や、露光時の光(エネルギー線)の照射量及び照射方法等は、後述するコア部形成工程(b)や、上部クラッド層形成工程(c)においても適用することができる。

[0047]

「(b)コア部形成工程]

前述の工程(a)で得られた下部クラッド層21の上に、コア部26を形成させる工程である(図6参照)。

この工程では、まず、下部クラッド層 2 1 上に、コア部形成用の感放射線性ポリシロキサン組成物を塗布し、乾燥させ、必要に応じてプリベークして、コア部用の薄膜を形成させる。

その後、コア部用の薄膜の上面に対して、所定のラインパターンを有するフォトマスクを介するなど、所定のパターン形成方法によって、光の照射を行なう。 照射後、現像液によって現像すれば、未硬化の不要な部分が除去され、露光部分 (硬化部分)のみからなるコア部26が形成される。

次いで、下部クラッド層21と同様に、ホットプレートやオーブン等の加熱手段を用いて、例えば30~400℃の温度で5~600分間ポストベークを行なえば、良好な硬化状態のコア部26を得ることができる。

[0048]

[(c)上部クラッド層形成工程]

前述の工程(b)によって得られたコア部26と下部クラッド層21とからなる硬化体の上に、上部クラッド層27を形成させる工程である(図7参照)。

この工程では、まず、コア部26と下部クラッド層21とからなる硬化体の上 方から、上部クラッド層形成用の感放射線性ポリシロキサン組成物を塗布し、乾燥させ、必要に応じてプリベークして、上部クラッド層用の薄膜を形成させる。

次いで、上部クラッド層用の薄膜の上面に対して、所定のラインパターンを有 するフォトマスクを介するなど、所定のパターン形成方法によって、光の照射を 行なう。照射後、現像液によって現像すれば、未硬化の不要な部分が除去され、 露光部分(硬化部分)のみからなる上部クラッド層27が形成される。

上部クラッド層 2 7 は、さらに、必要に応じて、前述の工程(a)における加熱処理(ポストベーク)と同様の加熱処理(ポストベーク)を施すことが好ましい。加熱処理(ポストベーク)を行なうことによって、硬度及び耐熱性に優れた上部クラッド層 2 7 を得ることができる。

[0049]

光導波路チップ20の各構成部分(上部クラッド層27、コア部26、下部クラッド層21)を形成させる際に、光学フィルタ挿入用孔25等を形成し得るような所定のフォトマスクを用い、正確に位置合わせをしながら各層を積層させて光導波路チップ20を作製することによって、全層または一部の層に亘って貫通した光ファイバ用ガイド部22,23,24及び光学フィルタ挿入用孔25を形成させることができる。

[0050]

光導波路チップ20の光学フィルタ挿入用孔25に、光学フィルタ28を挿入し固定することによって、光学部品(光合分波器)32を完成させることができる(図7及び図8参照)。なお、光学フィルタ28の好ましい種類としては、例えば、誘電体多層フィルタ等が挙げられる。

光学フィルタ28を固定する手段としては、例えば、UV接着剤による接着が挙げられる。UV接着剤は、室温において短時間で固定可能である点と、光反射による損失が小さい点で、好ましく用いられる。UV接着剤の具体例としては、例えば、紫外線硬化型のアクリレート樹脂やエポキシ樹脂等が挙げられる。

光学部品32は、例えば、シングルモード用光ファイバを接続するための光合 分波器として好適に用いられる。

[0051]

【実施例】

以下、本発明の実施例を説明する。ただし、本発明は、実施例の記載に限定されるものではなく、特許請求の範囲から逸脱しない限りにおいて種々の実施態様を含み得るものである。

(1) 感放射線性ポリシロキサン組成物の調製

① コア部形成用感放射線性組成物の調製

撹拌機の付いた容器内に、フェニルトリメトキシシラン(68.4g、0.34 モル)と、メチルトリメトキシシラン(131.6g、0.96 モル)と、イオン交換水(70.8g、3.94 モル)と、シュウ酸(0.1g、 $1.1×10^{-3}$ モル)とを収容した後、60 で 6 時間撹拌することによって、フェニルトリメトキシシラン及びメチルトリメトキシシランの加水分解を行なった。

[0052]

次いで、容器内にプロピレングリコールモノメチルエーテルを加えた後、エバポレータを用いて、加水分解で副生したメタノールを除去した。そして、最終的に、固形分を67重量%に調整した、ポリシロキサンを含有するプロピレングリコールモノメチルエーテル溶液を得た。以下、この溶液を「コア部形成用ポリシロキサン溶液」と称する。GPC分析によって求めたポリシロキサン溶液1の重量平均分子量は、2500であった。

[0053]

コア部形成用ポリシロキサン溶液 149.2g(固形分含有量:100g)、プロピレングリコールモノメチルエーテル 50.2g、トリフェニルスルフォニウム・トリフルオロメチルスルフォネート 1.0g、ヒドロキシメチルアントラセン 0.20g、2重量%のトリオクチルアミンを含むプロピレングリコールモノメチルエーテル溶液 0.5gを混合して、均一な溶液とすることによって、25%での粘度が 45m Pa·sであるコア部形成用感放射線性組成物 201.2g(固形分含有率:50重量%)を得た。

[0054]

得られたコア部形成用感放射線性組成物の屈折率を、次のようにして測定した。 。

まず、コア部形成用感放射線性組成物を、シリコンウエハ上に 10μ mの厚みとなるようにスピンコートした後、120で10分間プレベイク(前処理の加熱)し、さらに、高圧水銀灯(500m J/c m²)による光の照射(露光)を行なった。露光後、100で1分間ベイク(加熱)し、200で1時間ポス

トベイク(後処理の加熱)して、硬化膜を作製した。硬化膜の屈折率は、プリズムカップラー法による測定値として、 $1.30\mu m$ の波長の光に対して1.470であり、 $1.55\mu m$ の波長の光に対して1.469であった。

[0055]

② クラッド部形成用感放射線性組成物の調製

撹拌機の付いた容器内に、メチルメタクリレート(450g, 4.50モル)、メタアクリロキシプロピルトリメトキシシラン(50g, 0.20モル)、プロピレングリコールモノメチルエーテル(600g)、2,2'ーアゾビスー(2.4ージメチルバレロニトリル)(35g,0.14モル)を収容した後、系内を窒素置換した。その後、容器内の温度を70℃に設定し、6時間撹拌した。最終的に、固形分濃度が45重量%に調整された、アクリルポリマーを含有するプロピレングリコールモノメチルエーテル溶液(アクリルポリマー溶液)を得た

[0056]

得られたアクリルポリマー溶液(133.33g)、メチルトリメトキシシラン(231.36g, 1.70 モル)、フェニルトリメトキシシラン(193.48g, 0.97 モル)、イオン交換水(108.48g, 6.0 モル)、シュウ酸(0.30g, 3.32×10^{-3} モル)を容器内に収容した後、60 でで6時間撹拌することによって、フェニルトリメトキシシラン、メチルトリメトキシシラン、及びアクリルポリマー溶液の加水分解及び共縮合を行なった。

[0057]

次いで、エバポレータを用いて、加水分解で副生したメタノールを除去した。 最終的に、固形分が70重量%に調整された、ポリシロキサンを含有するプロピレングリコールモノメチルエーテル溶液(ポリシロキサン溶液)を得た。以下、得られたポリシロキサン溶液を「クラッド部形成用ポリシロキサン溶液」と称する。

クラッド部形成用ポリシロキサン溶液142.8g(固形分含有量:100g)、プロピレングリコールモノメチルエーテル20.5g、トリフェニルスルフォニウム・トリフルオロメチルスルフォネート2.0g、ヒドロキシメチルアン

トラセン 0.67g、 2 重量%のトリオクチルアミンを含むプロピレングリコールモノエチルエーテル溶液 0.5g を混合し、均一な溶液とすることによって、25 ℃での粘度が 2500 m Pa·s であるクラッド部形成用感放射線性組成物 166.6g (固形分含有率:61 重量%)を得た。

[0058]

得られたクラッド部形成用感放射線性組成物の屈折率を、次のようにして測定 した。

クラッド部形成用感放射線性組成物を、シリコンウエハ上に 10μ mの厚みとなるようにスピンコートした後、100℃で5分間プレベイク(前処理の加熱)し、高圧水銀灯(500m J/c m 2)による光照射で露光した後、100℃で2分間ベイク(加熱処理)し、さらに、200℃で1時間ポストベイク(後処理の加熱)して、硬化膜を作製した。硬化膜の屈折率は、プリズムカップラー法による測定値として、 1.30μ mの波長の光に対して1.465であり、 1.55μ mの波長の光に対して1.465であり、1.55

[0059]

(2) 光合分波器の製造

前述のコア部形成用感放射線性組成物及びクラッド部形成用感放射線性組成物を用いて、次のようにして光合分波器を製造した。なお、以下の説明は、図5~図8を参照して行なう。

「工程1]

光リソグラフィー加工によって、シリコンウエハ上にクラッド部形成用感放射 線性組成物からなる下部クラッド層21を形成させた(図5参照)。

下部クラッド層 2 1 は、入射、反射、透過の 3 つのポートの各々に対応させた 3 つの光ファイバ用ガイド部(すなわち、入射ポート側光ファイバ用ガイド部 2 2、反射ポート側光ファイバ用ガイド部 2 3、透過ポート側光ファイバ用ガイド部 2 4)、及び誘電体多層フィルタを挿入させるための光学フィルタ挿入用孔 2 5 を有するものである。下部クラッド層 2 1 の厚みは、5 8 . 5 μ m であった。

[0060]

なお、光ファイバ用ガイド部22,23,24は、下部クラッド層と一体的に

[0061]

[工程2]

フォトリソグラフ法によって、下部クラッド層 2 1 の上にコア部形成用感放射 線性組成物からなる Y字型のコア部 2 6 (幅 8 μ m、高さ 8 μ m)を形成させた (図 6)。

なお、コア部26の略中央部(Y字型の「Y」の中心付近)には、上述の工程 1で形成させた光学フィルタ挿入用孔25と同様の位置にて、コア部の遮断部分 (コア部形成用感放射線性組成物が形成されていない部分)を設けた。

[0062]

[工程3]

フォトリソグラフ法によって、下部クラッド層 2 1 及びコア部 2 6 の上に、クラッド部形成用感放射線性組成物からなる上部クラッド層 2 7 (厚み 3 0 μ m)を形成させた(図 7)。

上部クラッド層 2 7 は、下部クラッド層 2 1 のパターン形状と一致するように 形成させた。得られた光導波路チップ 2 0 は、入射ポート側光ファイバ用ガイド 部 2 2、反射ポート側光ファイバ用ガイド部 2 3、透過ポート側光ファイバ用ガ イド部 2 4、及び光学フィルタ挿入用孔 2 5 が各々、滑らかな内面を有するもの として形成されたものであった。

[0063]

「工程4]

光学フィルタ (誘電体多層フィルタ) 28を、工程3で得られた光導波路チップ20の光学フィルタ挿入用孔25に挿入して、UV接着剤で固定し、光学部品(光合分波器)32を得た(図8)。

なお、誘電体多層フィルタ28としては、1.31μmの光を透過させ、かつ、1.55μmの光を透過させずに反射させる特性を有するものを用いた。この

場合、 1.31μ mの光を、入射ポート側の光ファイバ29から光導波路チップ 20内に入射させると、入射した光は、主に透過ポート側(光ファイバ31の側)へと透過し、反射ポート側(光ファイバ30の側)に反射して出射する光量が 少なくなる。一方、 1.55μ mの光を、入射ポート側の光ファイバ29から光 導波路チップ 20 内に入射させると、入射した光は、主に反射ポート側(光ファイバ30の側)に反射して出射し、透過ポート側(光ファイバ31の側)へと透 過する光量が少なくなる。

[0064]

[工程5]

端面を研磨した外径 $1\ 2\ 5\ \mu$ m(コア径 $:\ 1\ 0\ \mu$ m)の3本のシングルモード 用石英ファイバ $2\ 9$, $3\ 0$, $3\ 1$ を、3つの光ファイバ用ガイド部 $2\ 2$, $2\ 3$, $2\ 4$ に挿入し、UV接着剤を用いて固定した(図8)。

[0065]

(3) 光導波路チップの光学特性の評価

得られた光合分波器32を用いて、次のようにして光導波路チップ20の光学 特性を評価した。

① 損失量の測定

波長1.31 μ mまたは1.55 μ mの光を、入射ポート側の光ファイバ29から光導波路チップ20に入射させて、反射ポート側の光ファイバ30、及び透過ポート側の光ファイバ31から出射する光量を、光量計(アンリツ社製;MT9810)のパワーメータによって測定し、入射光量との比較によって損失量を求めた。以下、反射ポート側の光ファイバ30で測定した損失量を、「反射ポートでの挿入損失」と称し、透過ポート側の光ファイバ31で測定した損失量を、「透過ポートでの挿入損失」と称する。

結果を表1に示す。

[0066]

【表1】

波 長 (μm)	透過ポートでの 挿入損失 (dB)	反射ポートでの 挿入損失 (dB)
1. 31	-3.7	<-,25
1.55	<-50	-4.8

[0067]

シングルモード用である1.31 μ m及び1.55 μ mの2つの波長の光を、光学部品32に入射すると、これら2つの波長の光は、フィルム誘電体多層膜フィルタ28の特性に基づいて、透過ポート側と反射ポート側とに振り分けられた。この際、表1に示すように、波長1.31 μ mの光の透過ポートでの挿入損失、及び、波長1.55 μ mの光の反射ポートでの挿入損失の値は、共に十分小さく、本発明の光導波路チップ20が、シングルモード用光ファイバに接続するのに好適な加工精度及び伝送効率を有していることが確認された。

[0068]

【発明の効果】

本発明の光導波路チップは、優れた加工性、伝送特性及び耐熱性を有する感放 射線性ポリシロキサン組成物によって少なくとも部分的に形成されているため、 光導波路の光軸と光ファイバの光軸とを高精度でかつ容易に一致させることがで き、かつ、光通信に必要な近赤外波長域の光に対して高い伝送効率を有すること に加えて、高温下に置かれた場合でも優れた性能が維持され、使用時に高い信頼 性(性能安定性)を期待することができる。

本発明の光導波路チップは、特に、マルチモード用光ファイバと比べてコア部分の直径寸法が小さいシングルモード用光ファイバに接続するための光学部品の構成部分として、好適に用いられる。

【図面の簡単な説明】

【図1】

光導波路チップの一例を示す斜視図である。

【図2】

基板上に下部クラッド層を形成させた状態を示す斜視図である。

【図3】

下部クラッド層の上にコア部を形成させた状態を示す斜視図である。

【図4】

光導波路チップの他の例を示す斜視図である。

【図5】

下部クラッド層の一例を示す平面図である。

図6】

下部クラッド層の上にコア部を形成させた状態を示す平面図である。

【図7】

下部クラッド層及びコア部の上に上部クラッド層を形成させて光導波路チップ を完成させた状態を示す平面図である。

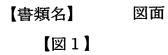
【図8】

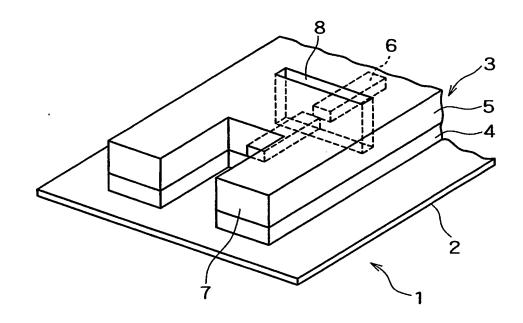
図7に示す光導波路チップに光学フィルタ及び光ファイバを取り付けた状態を 示す平面図である。

【符号の説明】

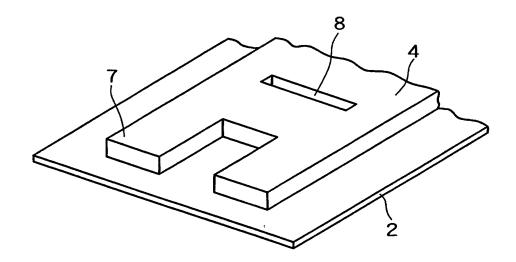
- 1,10,20 光導波路チップ
- 2, 12 支持体(基板)
- 3, 13 クラッド部
- 4.14.21 下部クラッド層
- 5. 15, 27 上部クラッド層
- 6, 16, 26 コア部
- 7.17 光ファイバ用ガイド部
- 8.18.25 光学フィルタ挿入用孔
- 22 入射ポート側光ファイバ用ガイド部
- 23 反射ポート側光ファイバ用ガイド部
- 24 透過ポート側光ファイバ用ガイド部
- 28 光学フィルタ (誘電体多層フィルタ)
- 29.30.31 シングルモード用光ファイバ

32 光学部品 (光合分波器)

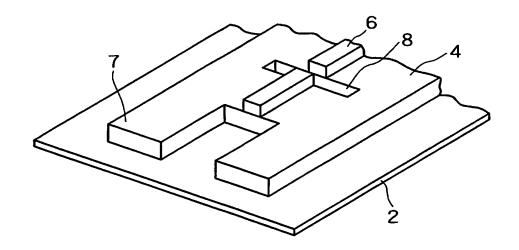




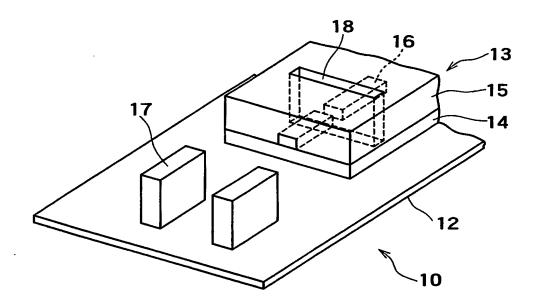
[図2]



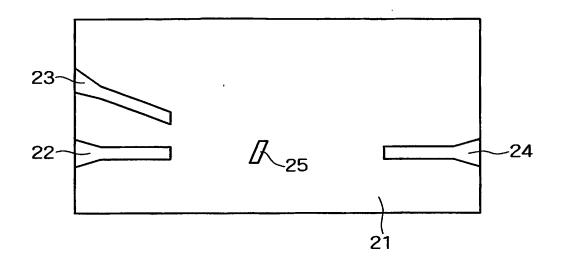
【図3】



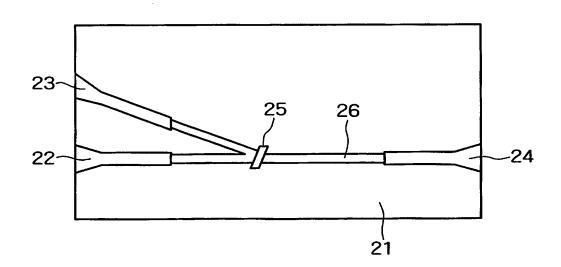
【図4】



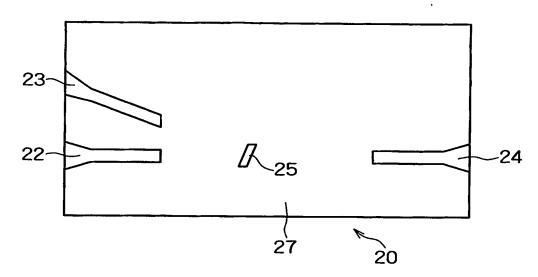
【図5】



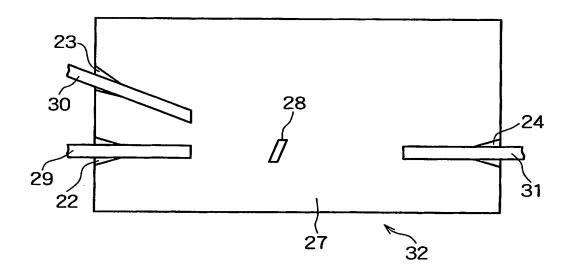
【図6】



【図7】



【図8】





【要約】

【課題】 シングルモード用光ファイバに対しても光軸同士を高い精度で合わせることができ、シングルモード光の伝送効率が高く、しかも、優れた耐熱性を有する光導波路チップを提供する。

【解決手段】 光導波路チップ1は、光導波路であるコア部6と、下部クラッド 層4と上部クラッド層5とからなるクラッド部3と、コア部6に接続されるシングルモード用光ファイバを位置決めするためにクラッド部3と一体的に形成されている光ファイバ用ガイド部7とを有する。光導波路チップ1の各構成部分は、感放射線性ポリシロキサン組成物をフォトリングラフ法によって積層して形成されている。クラッド部3よりもコア部6の屈折率の方が大きくなるように、少なくとも2種類の感放射線性ポリシロキサン組成物が用いられる。

【選択図】 図1

ページ: 1/E

認定・付加情報

特許出願の番号 特願 2 0 0 3 - 0 9 6 4 3 5

受付番号 50300534984

書類名 特許願

担当官 第一担当上席 0090

作成日 平成15年 4月 1日

<認定情報・付加情報>

【提出日】 平成15年 3月31日

特願2003-096435

出願人履歴情報

識別番号

[394023182]

1. 変更年月日

2001年 3月28日

[変更理由]

住所変更

住 所

神奈川県秦野市菩提69番地3

氏 名

光伸光学工業株式会社



出願人履歴情報

識別番号

[000004178]

1. 変更年月日

1997年12月10日

[変更理由]

名称変更

住 所 氏 名 東京都中央区築地2丁目11番24号

ジェイエスアール株式会社

2. 変更年月日 [変更理由] 2003年 5月 6日

住 所

住所変更

氏 名

東京都中央区築地五丁目6番10号

ジェイエスアール株式会社

3. 変更年月日

2003年 9月 名称変更

[変更理由] 住 所

東京都中央区築地五丁目6番10号

1日

氏 名

J S R 株式会社